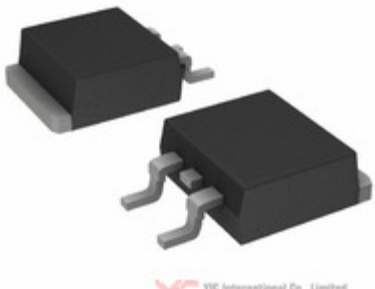










 	<h2 style="color: red;">HGT1S12N60A4DS</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> HGT1S12N60A4DS</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IGBT 600V 54A 167W D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">HGT1S12N60A4DS.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 227 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	HGT1S12N60A4DS
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 54A 167W D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	227 pcs Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.7V @ 15V, 12A
Testbedingung	390V, 12A, 10 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	17ns/96ns
Schaltenergie	55µJ (on), 50µJ (off)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	30ns
Leistung - max	167W
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	-
Gate-Ladung	78nC
Strom - Collector Pulsed (Icm)	96A
Strom - Kollektor (Ic) (max)	54A

HGT1S12N60A4DS Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, HGT1S12N60A4DS-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, HGT1S12N60A4DS Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ HGT1S12N60A4DS E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>HGT1S12N60C3</b> HARRIS HGT1S12N60C3 HARRIS</p>	 <p><b>HGT1S12N60A4DS</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 54A 167W D2PAK</p>	 <p><b>HGT1S10N120BNS</b> Fairchild/ON Semiconductor IGBT 1200V 35A 298W TO263AB</p>	 <p><b>HGT1S10N120BNST</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 1200V 35A 298W TO263AB</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>HGT1S12N60C3DS</b> FAIRCHILD HGT1S12N60C3DS FAIRCHILD</p>	 <p><b>HGT1S10N120BNS</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 1200V 35A 298W TO263AB</p>	 <p><b>HGT1S12N60A4S9A</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 54A 167W TO263AB</p>	 <p><b>HGT1S10N120BNST</b> Fairchild/ON Semiconductor IGBT 1200V 35A 298W TO263AB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

HGT1S12N60A4DS Fairchild/ON Semiconductor	HGT1S12N60A4DS Datenblatt	HGT1S12N60A4DS-Datenblätter	HGT1S12N60A4DS PDF	Fairchild/ON Semiconductor HGT1S12N60A4DS
HGT1S12N60A4DS Electronic	HGT1S12N60A4DS-Komponenten	HGT1S12N60A4DS-Verteiler	HGT1S12N60A4DS-Bild	HGT1S12N60A4DS-Teil
HGT1S12N60A4DS Preis	HGT1S12N60A4DS Hersteller	HGT1S12N60A4DS Bild	HGT1S12N60A4DS Aktie	HGT1S12N60A4DS Inventar
HGT1S12N60A4DS Neu	HGT1S12N60A4DS Original	HGT1S12N60A4DS garantiert	HGT1S12N60A4DS RFQ	HGT1S12N60A4DS Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited